



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

BAS16H

SOD-323 Switching Diode 开关二极管

■Features 特点

Fast Switching Speed 快的开关速度

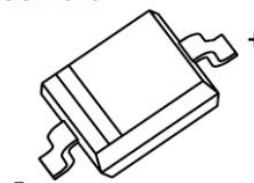
Surface mount device 表面贴装器件

High Conductance 高电导率

Case 封装:SOD-323

Marking 印字: A6

SOD-323



■Maximum Rating 最大额定值

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

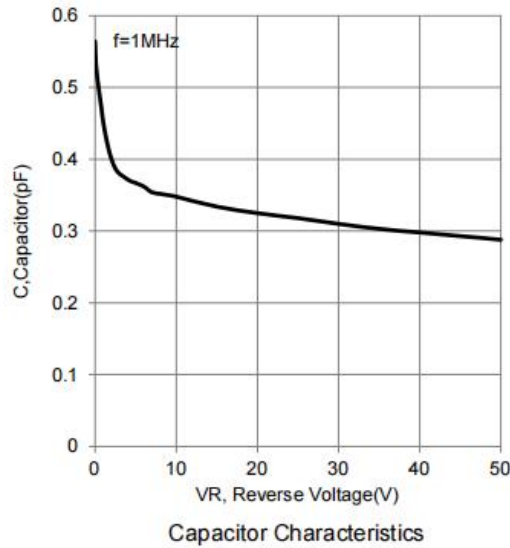
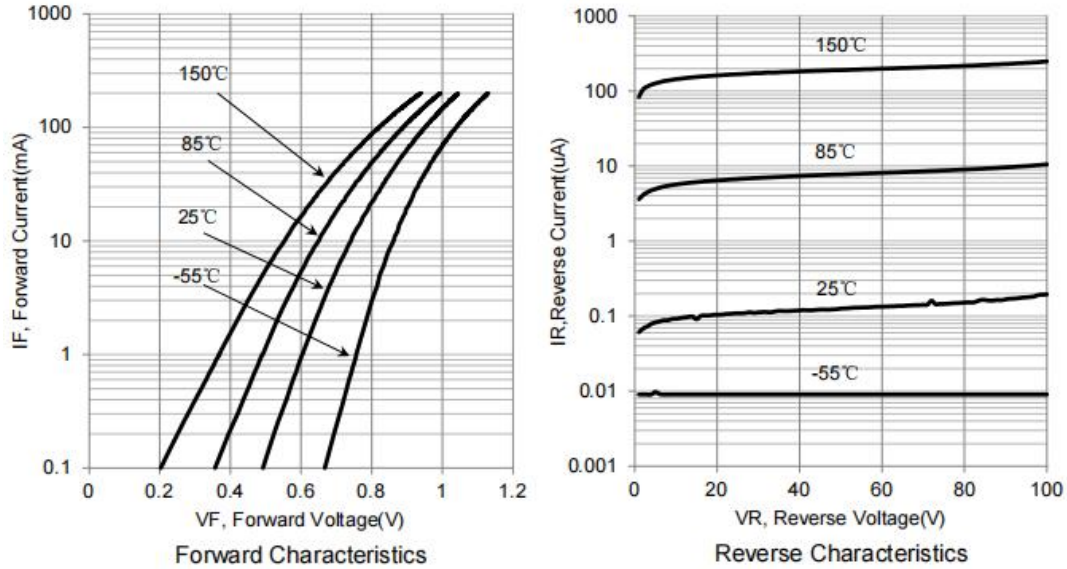
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 不重复反向峰值电压	V_{RM}	100	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R	100	V
Forward Rectified Output Current 正向工作电流	I_O	250	mA
Forward Rectified Peak Current 正向峰值电流	I_{FM}	500	mA
Non-Repetitive Peak Surge Current@ $t=1\mu\text{s}$ 不重复峰值浪涌电流@ $t=1\text{s}$	I_{FSM}	4 1.5	A
Power Dissipation 耗散功率	P_D	200	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	635	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction/Storage Temperature 结温/储藏温度	T_J, T_{stg}	-50to+150 $^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

■Electrical Characteristics 电特性

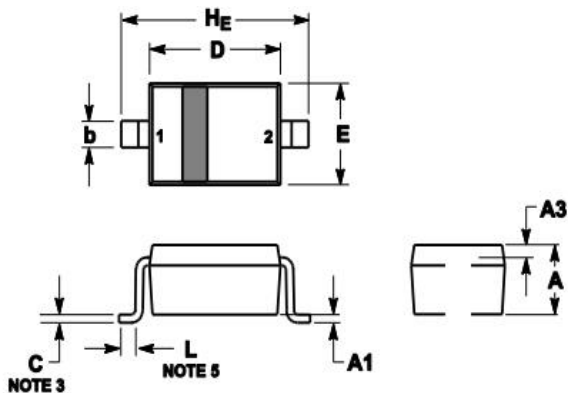
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Voltage 反向电压	V_R	75		V	$I_R=100\mu\text{A}$
Forward Voltage 正向电压	V_F		0.715 0.855 1.0 1.25	V	$I_F=1\text{mA}$ $I_F=10\text{mA}$ $I_F=50\text{mA}$ $I_F=150\text{mA}$
Reverse Current 反向电流	I_R		1 50 30	μA μA μA	$V_R=75\text{V}$ $V_R=75\text{V } T_J=150^{\circ}\text{C}$ $V_R=25\text{V } T_J=150^{\circ}\text{C}$
Junction Capacitance 结电容	C_J		2	pF	$V_R=4\text{V}, f=1\text{MHz}$
Revers Recovery Time 反向恢复时间	T_{rr}		4	nS	$I_{rr} = 0.1 * I_R, I_F = I_R = 10 \text{ mA}, R_L = 100\Omega$

Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



Dimension 外形封装尺寸



DIM	MILLIMETERS			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.8	0.9	1	0.031	0.035	0.04
A1	0	0.05	0.1	0	0.002	0.004
A3	0.15REF			0.006REF		
b	0.25	0.32	0.4	0.01	0.012	0.016
C	0.089	0.12	0.177	0.003	0.005	0.007
D	1.6	1.7	1.8	0.062	0.066	0.07
E	1.15	1.25	1.35	0.045	0.049	0.053
L	0.08			0.003		
H_E	2.3	2.5	2.7	0.09	0.098	0.105